

10N60放大电路mos管 ASEMI 放大电路mos管

产品名称	10N60放大电路mos管 ASEMI 放大电路mos管
公司名称	深圳市三佛科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区民清路50号油松民清大厦701
联系电话	0755-85279055 18902855590

产品详情

编辑-LL

MOS管这个器件有两个电极，分别是漏极D和源极S，无论是图一的N型还是图二的P型都是一块掺杂浓度较低的P型半导体硅衬底上，用半导体光刻、扩散工艺制作两个高掺杂浓度的N+/P+区，并用金属铝引出漏极D和源极S。然后在漏极和源极之间的N/P型半导体表面复盖一层很薄的二氧化硅（SiO₂）绝缘层膜，在再这个绝缘层膜上装上一个铝电极，放大电路mos管，作为栅极G。这就构成了一个N/P沟道（NPN型）增强型MOS管。

The UTC 8N80 is an N-channel mode Power FET , it uses UTC ' sadvanced technology to provide costumers planar stripe and DMOS

technology.

90N10/100N10-ASEMI-MOSFET管

编辑-LL

90N10/100N10-ASEMI-MOSFET管

1，MOS管种类和结构

MOSFET管是FET的一种（另一种是JFET），可以被制构成增强型或耗尽型，P沟道或N沟道共4种类型，但理论应用的只需增强型的N沟道MOS管和增强型的P沟道MOS管，所以通常提到NMOS，或者PMOS指的就是这两种。至于为什么不运用耗尽型的MOS管，不建议寻根究底。关于这两种增强型MOS管，比较常用的是NMOS。缘由是导通电阻小，且容易制造。所以开关电源和马达驱动的应用中，普通都用NMOS。下面的引见中，8N65放大电路mos管，也多以NMOS为主。MOS管的三个管脚之间有寄生电容存在，

这不是我们需求的，而是由于制造工艺限制产生的。寄生电容的存在使得在设计或选择驱动电路的时分要省事一些，8N80放大电路mos管，没有办法避免，后边再细致引见。在MOS管原理图上可以看到，漏极和源极之间有一个寄生二极管。这个叫体二极管，在驱动感性负载，这个二极管很重要。顺便说一句，体二极管只在单个的MOS管中存在，在集成电路芯片内部通常是没有的。

编辑-LL

4N65_场效应管ASEMI品质MOS管

4A , 650V , $R_{DS(ON)} = 2.2 \quad @V_{GS} = 10V/2A$

Low gate charge

Low C_{iss}

Fast switching

100% avalanche tested

Improved dv/dt capability

晶体管有N型channel所有它称为N-channel MOS管，或NMOS。P-channel MOS (PMOS) 管也存在，10N60放大电路mos管，是一个由轻掺杂的N型BACKGATE和P型source和drain组成的PMOS管。如果这个晶体管的GATE相对于BACKGATE正向偏置，电子就被吸引到表面，空穴就被排斥出表面。

10N60放大电路mos管-ASEMI-放大电路mos管由鼎芯实业（深圳）有限公司提供。鼎芯实业（深圳）有限公司（www.asemi360.com）是从事“电源IC,整流桥,肖特基,快恢复全系列”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李强。同时本公司（www.asemi.cn）还是从事三相整流桥型号，三相整流桥经销商，三相整流桥模块的厂家，欢迎来电咨询。